



日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 6月15日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-179591

出 願 人

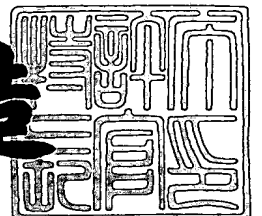
Applicant (s):

東芝電子エンジニアリング株式会社
株式会社東芝

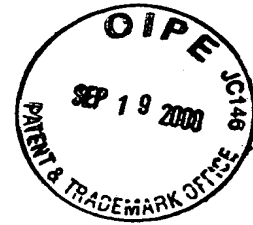
2000年 7月21日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2000-3055717



【書類名】	特許願
【整理番号】	12435901
【提出日】	平成12年 6月15日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H01L 33/00
【発明の名称】	半導体発光素子及びその製造方法
【請求項の数】	20
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝 マイクロエレクトロニクスセンター内
【氏名】	新 田 康 一
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝 マイクロエレクトロニクスセンター内
【氏名】	岡 崎 治 彦
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝 マイクロエレクトロニクスセンター内
【氏名】	渡 辺 幸 雄
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県川崎市川崎区日進町7番地1 東芝電子エンジニアリング株式会社内
【氏名】	古 川 千 里
【特許出願人】	
【識別番号】	000221339
【住所又は居所】	神奈川県川崎市川崎区日進町7番地1
【氏名又は名称】	東芝電子エンジニアリング株式会社
【特許出願人】	
【識別番号】	000003078



【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

【氏名又は名称】 株式会社 東 芝

【代理人】

【識別番号】 100064285

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐 藤 一 雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100088889

【弁理士】

【氏名又は名称】 橘 谷 英 俊

【選任した代理人】

【識別番号】 100082991

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐 藤 泰 和

【選任した代理人】

【識別番号】 100096921

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉 元 弘

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 004444

【納付金額】 21,000円

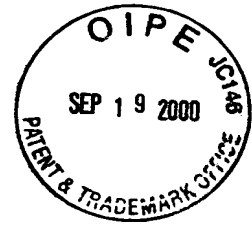
【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体発光素子及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

透光性を有する半導体基板と、
前記半導体基板上に、前記半導体基板に対して格子整合したバッファ層と、
前記バッファ層上に形成された発光層と、
前記バッファ層上に配置された第1の電極と、
前記発光層上に配置され、光反射性を有する第2の電極と、
を備えることを特徴とする半導体発光素子。

【請求項2】

半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された発光層と、
同一面上に配置された第1及び第2の電極と、
を備え、
前記発光層から発光した光が通過するように、前記半導体基板には光取り出し窓が形成されていることを特徴とする半導体発光素子。

【請求項3】

透光性を有する半導体基板上に、前記半導体基板に対して格子整合するようにバッファ層を形成する工程と、
前記バッファ層上に、第1のコンタクト層、第1のクラッド層、発光層、第2のクラッド層及び第2のコンタクト層を順次形成する工程と、
前記第1のクラッド層、前記発光層、前記第2のクラッド層及び前記第2のコンタクト層を一部除去して前記第1のコンタクト層の表面を露出させる工程と、
露出した前記第1のコンタクト層の表面上に第1の電極を形成する工程と、
前記第2のコンタクト層の表面上に、光反射性を有する第2の電極を形成する工程と、
を備えることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項4】

半導体基板上に、バッファ層、第1のコンタクト層、第1のクラッド層、発光層、第2のクラッド層及び第2のコンタクト層を順次形成する工程と、

前記第1のクラッド層、前記発光層、前記第2のクラッド層及び前記第2のコンタクト層を一部除去して前記第1のコンタクト層の表面を露出させる工程と、

露出した前記第1のコンタクト層の表面上に第1の電極を形成する工程と、

前記第2のコンタクト層の表面上に、光反射性を有する第2の電極を形成する工程と、

前記半導体基板に対し、前記第2の電極と対向する箇所に光取り出し窓を形成する工程と、

を備えることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項5】

透光性を有する半導体基板と、

前記半導体基板上に形成された、発光層とこの発光層の両面を挟持する第1、第2のクラッド層とを含むダブルヘテロ構造体と、

前記ダブルヘテロ構造体上に形成され、凹状の表面を有するコンタクト層と、
を備えることを特徴とする半導体発光素子。

【請求項6】

透光性を有する半導体基板上に、バッファ層、第1のクラッド層、発光層、第2のクラッド層及びコンタクト層を順次形成する工程と、

前記コンタクト層の表面を凹状に加工する工程と、

前記コンタクト層の表面上に、光反射性を有する第1の電極を形成する工程と

前記半導体基板の表面上に、前記第1の電極と対向する箇所が除去されるように第2の電極を形成する工程と、

を備えることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項7】

透光性を有する半導体基板上に、格子整合するようにバッファ層を形成する工程と、

前記バッファ層上に、第1のクラッド層、発光層、第2のクラッド層及びコン

タクト層を順次形成する工程と、

前記コンタクト層の表面を凹状に加工する工程と、

前記コンタクト層の表面上に、光反射性を有する第 1 の電極を形成する工程と

前記半導体基板の表面上に第 2 の電極を形成する工程と、

を備えることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 8】

半導体基板上に少なくとも発光層が形成された半導体発光素子において、

前記半導体発光素子が五角以上の多角柱、又は円柱の形状を有することを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 9】

面方向に発光する発光層を有する半導体発光素子において、

前記発光層の少なくとも一方の面側にフォトリソ結晶層を有することを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 10】

前記フォトリソ結晶層は、前記発光層に対し、前記化合物半導体発光素子における光取り出し面の反対側に形成されていることを特徴とする請求項 9 記載の半導体発光素子。

【請求項 11】

前記フォトリソ結晶層は、前記発光層に対し、前記半導体発光素子における光取り出し面側に形成されており、前記光取り出し面に対して略垂直方向に貫通転位が存在し、前記発光層から発光した光を通過させることを特徴とする請求項 9 記載の半導体発光素子。

【請求項 12】

半導体基板と、

前記半導体基板上に形成されたコンタクト層と、

前記コンタクト層上に形成された第 1 のクラッド層と、

前記第 1 のクラッド層上に形成された発光層と、

前記発光層上に形成された第 2 のクラッド層とを備え、

前記第 1 のクラッド層に接する前記コンタクト層の界面には凹凸が形成されており、屈折率に分布が存在することにより、前記発光層から発光した光がこの界面により反射されることを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 3】

半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された発光層とを備え、
前記半導体基板は、エッジがだれた形状を有することを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 4】

フォトニクス結晶層と、
前記フォトニクス結晶層の一方の面上と他方の面上にそれぞれ少なくとも 1 つずつ形成された発光素子とを備え、
前記発光素子はそれぞれ異なる発光波長で発光することを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 5】

透光性を有する半導体基板と、
前記半導体基板上に形成されたブラッグ反射層と、
前記ブラッグ反射層上に形成された活性層と、
前記活性層上に形成されたフォトニクス結晶層と、
を備えることを特徴とする半導体発光素子。

【請求項 1 6】

第 1 の半導体基板上に、バッファ層、第 1 のクラッド層、発光層、第 2 のクラッド層を順次形成する工程と、
第 2 の半導体基板上に、フォトニクス結晶層を形成する工程と、
前記第 2 のクラッド層と前記フォトニクス結晶層とを融着する工程と、
前記第 1 の半導体基板及び前記バッファ層を除去する工程と、
を備えることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 1 7】

透光性を有する第 1 の半導体基板上に、バッファ層、コンタクト層、第 1 のク

ラッド層、発光層、第 2 のクラッド層を順次形成する工程と、

第 2 の半導体基板上に、フォトニクス結晶層を形成する工程と、

前記第 1 の半導体基板と前記フォトニクス結晶層とを融着する工程と、

前記第 2 の半導体基板を除去する工程と、

を備え、

前記フォトニクス結晶層には、光取り出し面に対して略垂直方向に貫通転位が存在し、前記発光層から発光した光を通過させることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 1 8】

半導体基板上に、コンタクト層を形成する工程と、

前記コンタクト層の表面上に凹凸を形成する工程と、

前記コンタクト層上に、第 1 のクラッド層、発光層、第 2 のクラッド層を順次形成する工程とを備え、

前記第 1 のクラッド層に接する前記コンタクト層の界面に形成した凹凸によって屈折率に分布が存在し、前記発光層から発光した光がこの界面により反射されることを特徴とする化合物半導体発光素子の製造方法。

【請求項 1 9】

半導体基板上に、少なくとも発光層を形成する工程と、

前記半導体基板のエッジを除去する加工を行い、前記エッジがだれた形状とする工程と、

を備えることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【請求項 2 0】

透光性を有する第 1 の半導体基板上に、バッファ層を形成する工程と、

前記バッファ層上に、ブラッグ反射層を形成する工程と、

前記ブラッグ反射層上に、発光層、クラッド層、接着層を順次形成する工程と

、
第 2 の半導体基板上にフォトニクス結晶層を形成する工程と、

前記接着層を介して、前記クラッド層と前記フォトニクス結晶層とを接着する工程と、

前記第 2 の半導体基板を除去する工程と、
を備えることを特徴とする半導体発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体発光素子及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

半導体発光素子は、 $p-n$ 接合領域に注入された電子とホールが発光再結合を利用したデバイスである。そして、発光層の半導体材料を変えることで、赤外から紫外までの発光を実現することができる。

【0003】

ところが、半導体発光素子には、半導体結晶と大気の屈折率差による臨界角や結晶成長可能な基板での光吸収が存在する。このため、外部に取り出せる光は内部で発光した光のわずかな数%にしか過ぎない。

【0004】

従来の半導体発光素子の構成を、図 16 に示す。

【0005】

p 型半導体基板 1000 上に、多層反射膜 1001、 p 型コンタクト層 1002、 p 型クラッド層 1003、発光層として作用する活性層 1004、 n 型クラッド層 1005、 n 型コンタクト層 1006 を形成し、さらにコンタクト層 1002 上に n 型電極 1007、コンタクト層 1006 上に p 型電極 1008 を形成している。

【0006】

活性層 1004 で発光した光のうち、 n 型クラッド層 1005 側に出射された光は、クラッド層 1005 を通して外部に取り出される。

【0007】

一方、 p 型クラッド層 1003 側に出射された光は、多層反射膜 1001 で反射されて n 型クラッド層 1005 を通して外部に取り出される。

【0008】

この構造によれば、基板1000側に出射された光を反射膜1001で反射することにより、外部へ取り出すことができる。

【0009】

しかし、反射膜1001に対して垂直に入射しない光の反射率が低いこと、光取り出し面に光を遮蔽する電極1007、1008が存在すること、反射膜1001上に活性層1004を形成することにより結晶性が悪く寿命が短い等の問題があった。

【0010】

また、従来の他の半導体発光素子を図17に示す。n型GaP基板1101上に、n型InGaPバッファ層1102、n型InAlPクラッド層1103、発光層として作用するInGaAlP活性層1104、p型InAlPクラッド層1105、p型GaAsコンタクト層1106、さらにコンタクト層1106上にp型電極1107、基板1101上にn型電極1100を形成している。

【0011】

活性層1104で発光した光は、n電極1100及びp電極1107に反射され、p電極1107で遮蔽されていないコンタクト層1106から外部に取り出される。

【0012】

しかしながら、この構造では電極1107直下に集中した光を電極1107が遮っているため、外部に出すことができないという問題があった。

【0013】

また、図17に示された従来の素子では、活性層1104で発光した光は、結晶と空気との屈折率差が原因となって、発光した光のうち数%しか外部に取り出すことができなかった。

【0014】

ところで、半導体発光素子には、赤色から緑色を発光するために、GaAs系半導体材料を用いた化合物半導体発光素子、紫外光領域から青色、緑色領域に至る発光を行うために、 $Al_xGa_{1-x-y}In_yN$ ($0 \leq x, y \leq 1, x+y$

≤ 1) を用いた窒化ガリウム系化合物半導体発光素子が実用化されている。

【0015】

ところが、このような発光素子は、一般に屈折率 ($GaN=2.67$ 、 $GaAs=3.62$) が高いため、臨界角 ($GaN=21.9$ 度、 $GaAs=16.0$ 度) が小さく、光取り出し効率が低いという問題点があった。

【0016】

また、 $GaAs$ 系においては、基板における光吸収が大きく、発光した光が基板に吸収されてしまい光取り出し効率が低かった。

【0017】

従来のガリウム砒素系化合物半導体発光素子の一例を図19に示す。

【0018】

$n-GaAs$ 基板1300に、 $n-GaAs$ バッファ層1301、 $n-InGaAlP$ クラッド層1302、 $InGaAlP$ 活性層1303、 $p-InGaAlP$ クラッド層1304、 $p-AlGaAs$ 電流拡散層1305を順次結晶成長する。さらに、 $p-AlGaAs$ 電流拡散層1305上には p 側電極パッド1307、 $n-GaN$ 基板1300上に n 側電極1306を形成する。

【0019】

このような構造では、 p 側電極1307から流れた電流は、 $p-AlGaAs$ 電流拡散層1305で広げられ、 $p-InGaAlP$ クラッド層1304から $InGaAlP$ 活性層1303に電流が注入されて発光し、その光は $p-AlGaAs$ 電流拡散層1305を通して素子外部に取り出される。

【0020】

このような構造の $GaAs$ 系化合物半導体発光素子においては、活性層1303で発光した光のうち、基板1300側に出射した光は基板1300により吸収されてしまい、素子外部へ光を取り出すことができないという問題があった。具体的には、発光した光のうち50%は取り出すことができず、高輝度化のためには致命的であった。

【0021】

【発明が解決しようとする課題】

上述のように、従来は光取り出し効率が低いという問題があった。

【0022】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、光取り出し効率を向上させ、高輝度化を実現することが可能な半導体発光素子及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0023】

【課題を解決するための手段】

本発明の半導体発光素子は、透光性を有する半導体基板と、前記半導体基板上に、前記半導体基板に対して格子整合したバッファ層と、前記バッファ層上に形成された発光層と、前記バッファ層上に配置された第1の電極と、前記発光層上に配置され、光反射性を有する第2の電極とを備えることを特徴とする。

【0024】

また本発明の半導体発光素子は、半導体基板と、前記半導体基板上に形成された発光層と、同一面上に配置された第1及び第2の電極とを備え、前記発光層から発光した光が通過するように、前記半導体基板には光取り出し窓が形成されていることを特徴とする。

【0025】

本発明の半導体発光素子の製造方法は、透光性を有する半導体基板上に、前記半導体基板に対して格子整合するようにバッファ層を形成する工程と、前記バッファ層上に、第1のコンタクト層、第1のクラッド層、発光層、第2のクラッド層及び第2のコンタクト層を順次形成する工程と、前記第1のクラッド層、前記発光層、前記第2のクラッド層及び前記第2のコンタクト層を一部除去して前記第1のコンタクト層の表面を露出させる工程と、露出した前記第1のコンタクト層の表面上に第1の電極を形成する工程と、前記第2のコンタクト層の表面上に、光反射性を有する第2の電極を形成する工程とを備えることを特徴とする。

【0026】

また本発明の半導体発光素子の製造方法は、半導体基板上に、バッファ層、第1のコンタクト層、第1のクラッド層、発光層、第2のクラッド層及び第2のコンタクト層を順次形成する工程と、前記第1のクラッド層、前記発光層、前記第

2のクラッド層及び前記第2のコンタクト層を一部除去して前記第1のコンタクト層の表面を露出させる工程と、露出した前記第1のコンタクト層の表面上に第1の電極を形成する工程と、前記第2のコンタクト層の表面上に、光反射性を有する第2の電極を形成する工程と、前記半導体基板に対し、前記第2の電極と対向する箇所に光取り出し窓を形成する工程とを備えることを特徴とする。

【0027】

本発明の半導体発光素子は、透光性を有する半導体基板と、前記半導体基板上に形成された、発光層とこの発光層の両面を挟持する第1、第2のクラッド層とを含むダブルヘテロ構造体と、前記ダブルヘテロ構造体上に形成され、凹状の表面を有するコンタクト層とを備えている。

【0028】

本発明の半導体発光素子の製造方法は、透光性を有する半導体基板上に、バッファ層、第1のクラッド層、発光層、第2のクラッド層及びコンタクト層を順次形成する工程と、前記コンタクト層の表面を凹状に加工する工程と、前記コンタクト層の表面上に、光反射性を有する第1の電極を形成する工程と、前記半導体基板の表面上に、前記第1の電極と対向する箇所が除去されるように第2の電極を形成する工程とを備える。

【0029】

あるいは、本発明の半導体発光素子の製造方法は、透光性を有する半導体基板上に、格子整合するようにバッファ層を形成する工程と、前記バッファ層上に、第1のクラッド層、発光層、第2のクラッド層及びコンタクト層を順次形成する工程と、前記コンタクト層の表面を凹状に加工する工程と、前記コンタクト層の表面上に、光反射性を有する第1の電極を形成する工程と、前記半導体基板の表面上に第2の電極を形成する工程とを備えることを特徴とする。

【0030】

本発明の半導体発光素子は、半導体基板上に少なくとも発光層が形成され、前記半導体発光素子が五角以上の多角柱、又は円柱の形状を有することを特徴とする。

【0031】

また本発明の半導体発光素子は、面方向に発光する発光層を有する半導体発光素子であって、前記発光層の少なくとも一方の面側にフォトニクス結晶層を有することを特徴とする。

【 0 0 3 2 】

前記フォトニクス結晶層は、前記発光層に対し、前記化合物半導体発光素子における光取り出し面の反対側に形成されていてもよい。

【 0 0 3 3 】

あるいは、前記フォトニクス結晶層は、前記発光層に対し、前記半導体発光素子における光取り出し面側に形成されており、前記光取り出し面に対して略垂直方向に貫通転位が存在し、前記発光層から発光した光を通過させるものであってよい。

【 0 0 3 4 】

本発明の半導体発光素子は、半導体基板と、前記半導体基板上に形成されたコンタクト層と、前記コンタクト層上に形成された第1のクラッド層と、前記第1のクラッド層上に形成された発光層と、前記発光層上に形成された第2のクラッド層とを備え、前記第1のクラッド層に接する前記コンタクト層の界面には凹凸が形成されており、屈折率に分布が存在することにより、前記発光層から発光した光がこの界面により反射されることを特徴とする。

【 0 0 3 5 】

また本発明の半導体発光素子は、半導体基板と、前記半導体基板上に形成された発光層とを備え、前記半導体基板は、エッジがだれた形状を有する。

【 0 0 3 6 】

あるいは、本発明の半導体発光素子は、フォトニクス結晶層と、前記フォトニクス結晶層の一方の面上と他方の面上にそれぞれ少なくとも1つずつ形成された発光素子とを備え、前記発光素子はそれぞれ異なる発光波長で発光することを特徴とする。

【 0 0 3 7 】

また本発明の半導体発光素子は、透光性を有する半導体基板と、前記半導体基板上に形成されたブラッグ反射層と、前記ブラッグ反射層上に形成された活性層

と、前記活性層上に形成されたフォトニクス結晶層とを備えている。

【 0 0 3 8 】

本発明の半導体発光素子の製造方法は、第 1 の半導体基板上に、バッファ層、第 1 のクラッド層、発光層、第 2 のクラッド層を順次形成する工程と、第 2 の半導体基板上に、フォトニクス結晶層を形成する工程と、前記第 2 のクラッド層と前記フォトニクス結晶層とを融着する工程と、前記第 1 の半導体基板及び前記バッファ層を除去する工程とを備える。

【 0 0 3 9 】

また本発明の半導体発光素子の製造方法は、透光性を有する第 1 の半導体基板上に、バッファ層、コンタクト層、第 1 のクラッド層、発光層、第 2 のクラッド層を順次形成する工程と、第 2 の半導体基板上に、フォトニクス結晶層を形成する工程と、前記第 1 の半導体基板と前記フォトニクス結晶層とを融着する工程と、前記第 2 の半導体基板を除去する工程とを備え、前記フォトニクス結晶層には、光取り出し面に対して略垂直方向に貫通転位が存在し、前記発光層から発光した光を通過させる。

【 0 0 4 0 】

あるいは、本発明の半導体発光素子の製造方法は、半導体基板上に、コンタクト層を形成する工程と、前記コンタクト層の表面上に凹凸を形成する工程と、前記コンタクト層上に、第 1 のクラッド層、発光層、第 2 のクラッド層を順次形成する工程とを備え、前記第 1 のクラッド層に接する前記コンタクト層の界面に形成した凹凸によって屈折率に分布が存在し、前記発光層から発光した光がこの界面により反射されることを特徴とする。

【 0 0 4 1 】

本発明の半導体発光素子は、半導体基板上に、少なくとも発光層を形成する工程と、前記半導体基板のエッジを除去する加工を行い、前記エッジがだれた形状とする工程とを備えている。

【 0 0 4 2 】

また本発明の半導体発光素子の製造方法は、透光性を有する第 1 の半導体基板上に、バッファ層を形成する工程と、前記バッファ層上に、ブラッグ反射層を形

成する工程と、前記ブラッグ反射層上に、発光層、クラッド層、接着層を順次形成する工程と、第2の半導体基板上にフォトニクス結晶層を形成する工程と、前記接着層を介して、前記クラッド層と前記フォトニクス結晶層とを接着する工程と、前記第2の半導体基板を除去する工程とを備えることを特徴としている。

【0043】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0044】

(1) 第1の実施の形態

図1に、本発明の第1の実施の形態による半導体発光素子の構成を示す。

【0045】

ZnSeから成る透光性を有する半導体基板100上に、 $\text{In}(x_1)\text{Ga}(y_1)\text{Al}(1-x_1-y_1)\text{P}$ からなるバッファ層101、 $\text{In}(x_2)\text{Ga}(y_2)\text{Al}(1-x_2-y_2)\text{P}$ からなるn型コンタクト層102、 $\text{In}(x_3)\text{Ga}(y_3)\text{Al}(1-x_3-y_3)\text{P}$ からなるn型クラッド層103、 $\text{In}(x_4)\text{Ga}(y_4)\text{Al}(1-x_4-y_4)\text{P}$ からなる活性層104、 $\text{In}(x_5)\text{Ga}(y_5)\text{Al}(1-x_5-y_5)\text{P}$ からなるp型クラッド層105、 $\text{In}(x_6)\text{Ga}(y_6)\text{Al}(1-x_6-y_6)\text{P}$ からなるp型コンタクト層106を順次形成していく。

【0046】

また、一部エッチング除去したn型コンタクト層102上に、AuGeからなるn型電極107、p型コンタクト層106上にAuZnから成るp型電極108を形成する。ここで $0 \leq x_1, \dots, x_6, y_1, \dots, y_6, x_1+y_1, \dots, x_6+y_6 \leq 1$ とする。

【0047】

ここで、電極材には、コンタクト層とオーミックコンタクトをとることが可能なものであること、また光反射率が高いことが望ましい。

【0048】

活性層104で発光した光は、半導体基板100を通過して外部に取出され、

さらに p 型電極 108 側に出射した光は電極 108 で反射され、同じく基板 100 を透過して外部に取出される。光取り出し面に傷害物がないため、有効に素子内部の光を取り出すことができるので、光取り出し効率が向上する。

【0049】

また、基板 100 に用いた ZnSe は、格子定数が 5.667 オングストロームである。しかし、基板 100 上に形成した $\text{In}(x)\text{Ga}(y)\text{Al}(1-x-y)$ P 層の組成 x 、 y を変えることで、5.451 オングストロームから 5.868 オングストロームまで格子定数を制御することができる。このため、ZnSe 基板 100 に格子整合した発光層 104、あるいは格子整合はしないが臨界膜厚以内となる発光層 104 を結晶性良く形成することができる。

【0050】

クラッド層 103 とコンタクト層 106 の組成は、活性層 104 のバンドギャップより大きくなるように調整することで、内部吸収がない構造も実現することができる。

【0051】

また、活性層 104 の組成を変えることで、赤色から緑色まで実現可能である。さらに、厚さ数 10 オングストロームからなる量子井戸層を用いた単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることで、発光効率の向上と長寿命を実現することができる。

【0052】

n 型電極 107 は、p 型コンタクト層 106 に n 型不純物をイオン注入し、あるいは拡散することによって形成する。これにより、p 型電極 108 と n 型電極 107 とが同一面上に形成される。これにより、p 型電極 108 を放熱板に直接接着することが可能である。従って、放熱性が向上するので、数 A の高電流まで、光出力が飽和することなく動作することが可能である。

【0053】

(2) 第 2 の実施の形態

図 2 に、本発明の第 2 の実施の形態による半導体発光素子の構成を示す。

【0054】

GaAs からなる半導体基板 200 上に、 $\text{In}(x_1)\text{Ga}(y_1)\text{Al}(1-x_1-y_1)$ P からなるバッファ層 201、 $\text{In}(x_2)\text{Ga}(y_2)\text{Al}(1-x_2-y_2)$ P からなる n 型コンタクト層 202、 $\text{In}(x_3)\text{Ga}(y_3)\text{Al}(1-x_3-y_3)$ P からなる n 型クラッド層 203、 $\text{In}(x_4)\text{Ga}(y_4)\text{Al}(1-x_4-y_4)$ P からなる活性層 204、 $\text{In}(x_5)\text{Ga}(y_5)\text{Al}(1-x_5-y_5)$ P からなる p 型クラッド層 205、 $\text{In}(x_6)\text{Ga}(y_6)\text{Al}(1-x_6-y_6)$ P からなる p 型コンタクト層 206 を順次形成する。

【0055】

さらに、一部エッチング除去した n 型コンタクト層 202 上に AuGe からなる n 型電極 207、p 型コンタクト層 206 上に AuZn からなる p 型電極 208 を形成する。

【0056】

そして、活性層 204 を挟んで p 型電極 208 と対向した位置に光を取り出すことができるように、基板 200 に対して光取り出し窓 209 を形成している。ここで、 $0 \leq x_1, \dots, x_6, y_1, \dots, y_6, x_1+y_1, \dots, x_6+y_6 \leq 1$ とする。

【0057】

活性層 204 で発光した光は、光取り出し窓 209 を通して外部に取り出される。さらに、p 型電極 208 側に出射した光は、電極 208 で反射されて同じく窓 209 を透過して外部に取り出される。

【0058】

また、電極 208 の大きさであるが、電極 208 が光取り出し窓 209 より大きいと、光の一部が基板 200 に吸収されて十分に取り出すことができなくなる。そこで、電極 208 は光取り出し窓 209 より小さいことが望ましい。このようにすることで、活性層 204 から発光した光を有効に取り出すことができるので、素子の光出力が増加する。

【0059】

本実施の形態によれば、光取り出し面に障害物が存在しないので、有効に内部

の光を取り出すことができる。また、クラッド層203、205とコンタクト層202、206の組成は、活性層204のバンドギャップより大きくなるように調整することで、内部吸収がない構造を実現することができる。

【0060】

また、活性層204の組成を変えることで、赤色から緑色までの発光が実現可能となる。

【0061】

さらに、活性層204の構造を、厚さ数10オングストロームからなる量子井戸層を用いた単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることで、発光効率の向上と長寿命とが実現される。

【0062】

n型電極207は、p型コンタクト層206からn型不純物をイオン注入し拡散した領域を形成することで、p型電極208とn型電極207とが同一面上に形成される。これにより、p型電極208を放熱板に直接接着することができるため、数オングストロームの高電流まで、光出力が飽和することなく動作が可能である。

【0063】

(3) 第3の実施の形態

本発明の第3の実施の形態による素子の構成を図3に示す。

【0064】

n型GaPからなる基板300上に、 $\text{In}(x_1)\text{Ga}(y_1)\text{Al}(1-x_1-y_1)\text{P}$ から成るn型バッファ層301、 $\text{In}(x_2)\text{Ga}(y_2)\text{Al}(1-x_2-y_2)\text{P}$ からなるn型クラッド層302、 $\text{In}(x_3)\text{Ga}(y_3)\text{Al}(1-x_3-y_3)\text{P}$ からなる活性層303、 $\text{In}(x_4)\text{Ga}(y_4)\text{Al}(1-x_4-y_4)\text{P}$ からなるp型クラッド層304、 $\text{In}(x_5)\text{Ga}(x_5)\text{Al}(1-x_5-y_5)\text{P}$ からなるp型コンタクト層305を順次形成する。
n型GaP基板300上に、AuGeNiからなるn型電極306を形成する。n型電極306には、光取り出し窓308が形成されている。さらに、表面を凹状にエッチング除去したp型コンタクト層305上に、AuZnからなるp

型電極 3 0 7 を形成する。

【0 0 6 5】

ここで、 $x a + y a \leq 1$ で、 $0 \leq x a$ 、 $y a \leq 1$ 、 a は 1 ~ 5 である。

【0 0 6 6】

活性層 3 0 3 で発光した光は、矢印 A のように直進して p 型電極 3 0 6 側の光取り出し窓 3 0 8 から素子の外部へ取り出される。また、矢印 B で示された光は、コンタクト層 3 0 5 の凹面上に形成された p 型電極 3 0 7 下で反射され、側面から外部に取り出される。

【0 0 6 7】

図 1 7 に示された従来の素子では、p 型電極 1 1 0 7 で反射された光は、n 型電極 1 1 0 0 でさらに反射され、結晶内部の不純物等に吸収されて熱に変換され、外部に取り出すことができなかった。このような光を、本実施の形態によれば有効に外部に取り出すことができるので、光取り出し効率が向上する。

【0 0 6 8】

ここで、クラッド層 3 0 2 及び 3 0 4 と、コンタクト層 3 0 5 の組成は、活性層 3 0 3 のバンドギャップより大きくなるように調整することで、内部吸収がない構造を実現することができる。

【0 0 6 9】

また、活性層 3 0 3 の組成を変えることで、赤色から緑色まで発光が可能となる。

【0 0 7 0】

さらに、活性層 3 0 3 の構造を、厚さ数 1 0 オングストロームからなる量子井戸層を用いた単一量子井戸構造や、多重量子井戸構造とすることで、発光効率の向上と長寿命とを実現することができる。

【0 0 7 1】

(4) 第 4 の実施の形態

次に、本発明の第 4 の実施の形態について、図 4 を用いて説明する。本実施の形態は、半導体基板として ZnSe を用いた場合に相当する。

【0 0 7 2】

n型ZnSeから成る基板400上に、基板400に格子整合したIn(x1)Ga(y1)Al(1-x1-y1)Pから成るn型バッファ層401、In(x2)Ga(y2)Al(1-x2-y2)Pから成るn型クラッド層402、In(x3)Ga(y3)Al(1-x3-y3)Pから成る活性層403、In(x4)Ga(y4)Al(1-x4-y4)Pから成るp型クラッド層404、In(x5)Ga(y5)Al(1-x5-y5)Pから成るp型コンタクト層405を順次形成する。

【0073】

さらに、n型ZnSe基板400上に、AuGeNiから成るn電極406を形成し、一部エッチング除去したp型コンタクト層405上にAuZnから成るp型電極407を形成する。

【0074】

ここで、各層401～405における組成比x1～x5、y1～y5は、n型ZnSe基板400に対して格子整合が可能な範囲で調整する必要がある。また、p型クラッド層404及びn型クラッド層402のバンドギャップは、活性層403のバンドギャップよりも大きく設定することで、ダブルヘテロ効果をより有効に得ることができる。

【0075】

上記構成によれば、上記第3の実施の形態と同様に、p型コンタクト層405の表面を凹状にエッチング除去している。このため、活性層403で発光した光が、p型電極407下で反射されて端面から取り出すことができるので、取り出し効率が向上する。

【0076】

また、素子の寸法に関し、従来の素子では一般に縦300 μ m×横300 μ mであった。本実施の形態では、縦100 μ m×横100 μ mとすることで、素子内部における光の吸収を減少させて、光取り出し効率を向上させることができる。具体的には、素子全体として光出力が約2倍に向上する。

【0077】

活性層403の組成比x3、y3を変えることにより、赤色から緑色までの発

光を実現することができる。また、素子の厚さが約数10オングストロームの量子井戸構造とすることで、ZnSe基板による応力の影響を少なくして長寿命化を達成することができる。

【0078】

(5) 第5の実施の形態

図5に、本発明の第5の実施の形態の構成を示す。

【0079】

n型GaPからなる半導体基板500上に、 $\text{In}(x_1)\text{Ga}(y_1)\text{Al}(1-x_1-y_1)\text{P}$ からなるn型バッファ層501、 $\text{In}(x_2)\text{Ga}(y_2)\text{Al}(1-x_2-y_2)\text{P}$ からなるn型クラッド層502、 $\text{In}(x_3)\text{Ga}(y_3)\text{Al}(1-x_3-y_3)\text{P}$ からなる活性層503、 $\text{In}(x_4)\text{Ga}(y_4)\text{Al}(1-x_4-y_4)\text{P}$ からなるP型クラッド層504、 $\text{In}(x_5)\text{Ga}(y_5)\text{Al}(1-x_5-y_5)\text{P}$ からなるP型コンタクト層505を順次形成する。

【0080】

n型GaP基板500上に、AuGeNiからなるn型電極506、P型コンタクト層505上にAuZnからなるP型電極507を形成する。

【0081】

ここで、 $x_a + y_a < 1$ で、 $0 \leq x_a$ 、 $y_a \leq 1$ 、 a は1～5である。

【0082】

そして、素子形状として、図5に示されたように表面が八角形である八角柱に加工されている。これにより、従来の素子のような表面が四角である四角柱の場合において四隅に放射された光も、この四隅の部分が切断された形状となることから、全反射されることなく外部へ取り出すことができる。

【0083】

ここで、素子形状は八角形に限らず、五角形以上であればよい。角数が多いほど光の取り出し効率は向上する。さらに、素子形状が、表面が円形である円柱になると、さらに光の取り出し効率が向上する。

【0084】

クラッド層502及び504と、コンタクト層505の組成は、活性層503のバンドギャップより大きくなるように調整することで、内部吸収がない構造が実現される。また、活性層503の組成を変えることで赤色から緑色まで発光が実現可能である。

【0085】

さらに、厚さ数10オングストロームからなる量子井戸層を用いた単一量子井戸構造、多重量子井戸構造とすることで、発光効率の向上と長寿命とを実現することができる。

【0086】

(6) 第6の実施の形態

図6に、本発明の第6の実施の形態を示す。

【0087】

n型Ga_Nからなる基板600上に、In(x₁)Ga(y₁)Al(1-x₁-y₁)Nからなるn型バッファ層601、In(x₂)Ga(y₂)Al(1-x₂-y₂)Nからなるn型クラッド層602、In(x₃)Ga(y₃)Al(1-x₃-y₃)Nからなる活性層603、In(x₄)Ga(y₄)Al(1-x₄-y₄)NからなるP型クラッド層604、In(x₅)Ga(y₅)Al(1-x₅-y₅)NからなるP型コンタクト層605を順次形成する。

【0088】

n型Ga_N基板600上に、TiAuからなるn型電極606、P型コンタクト層605上にNiAuからなるP型電極607を形成する。

【0089】

ここで、 $x_a + y_a \leq 1$ で、 $0 \leq x_a$ 、 $y_a \leq 1$ 、 a は1～5である。

【0090】

そして、図6に示されたように、素子形状を、表面が八角形である八角柱に加工したことにより、光取り出し効率が向上する。素子形状は八角形に限らず、5角形以上の多角形であればよく、さらに円柱にすることで光取り出し効率が向上する。

【0091】

クラッド層602及び604とコンタクト層605の組成は、活性層603のバンドギャップより大きくなるように調整することで、内部吸収がない構造が実現できる。

【0092】

また、活性層603の組成を変えることで紫外から赤色まで発光が実現可能となる。

【0093】

さらに、厚さ数10Åからなる量子井戸層を用いた単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることで、発光効率の向上と長寿命が実現できる。

【0094】

(7) 第7の実施の形態

ところで、近年いわゆるフォトニクス結晶が実用化されつつある。フォトニクス結晶とは、媒質に周期的な屈折率分布を設けたものであって、2次元・3次元となるにつれてその効果が増大し、特徴的な光学特性を示す。

【0095】

フォトニクス結晶の特徴は、バンドギャップの存在に起因する。バンドギャップ中では光の状態が存在しないため、バンドギャップに相当する光子エネルギーを持つ光は、この結晶中に存在することができない。そこで、外から結晶に入射した光は反射されることになる。また、結晶中に欠陥を線状に導入すると、そこには光子の存在が許される。このため、光閉じ込め効果や導波路が実現される。

【0096】

フォトニクス結晶の一例としては、ウェーハ接着技術を用いたものとして野田等の以下の文献に開示されている。

【0097】

電子情報通信学会誌、1999年3月、第232～241頁

図18に、その製造方法を工程別に示す。図18(a)に示されたように、GaAs基板1200上に、AlGaAs層1201、GaAs層1202を形成する。

【0098】

図18(b)に示されたように、GaAs層1202をパターニングし、格子状に加工する。

【0099】

このような加工を施した基板と、同じ構成を有するGaAs基板1210、AlGaAs層1211、GaAs層1212から成る基板とを用意し、図18(c)に示されたように格子状のGaAs層1202とGaAs層1212とが直交するように位置あわせしながら融着する。

【0100】

そして、図18(d)に示されたように、一方の基板1210及びAlGaAs層1211を選択エッチャントで除去する。

【0101】

以上の図18(a)～図18(d)の工程をさらに繰り返すことで、図18(e)に示されたように、GaAs系半導体材料と空気とから成る回折格子を有するフォトニクス結晶を作製する。ここで、互いに平行する一つおきの回折格子は、発光する光の半周期分位相がずれている必要がある。

【0102】

このようなフォトニクス結晶を用いた本発明の第7の実施の形態を、図7を用いて説明する。

【0103】

図7(a)に示されたように、p-GaAs基板700上に、MOCVD法によりn-GaAsバッファ層701、p-GaNコンタクト層712、p-InGaAlPクラッド層702、InGaAlP活性層703、n-InGaAlPクラッド層704を順次結晶成長させる。

【0104】

これとは別に、上述した工程を経てフォトニクス結晶705を作製し、n-InGaAlPクラッド層704上に融着させる。フォトニクス結晶705上に、n-GaAs層706を形成する。

【0105】

p-GaAs基板700及びn-GaAsバッファ層701を除去する。さら

に、図7(b)のように、 n -GaAs層706上に n 電極708を形成し、 p - $AlGaP$ 層703上に p 型透明電極709を形成する。さらに、 p 型透明電極709の一部を除去して、ブロック層711を形成し、 p 型透明電極709からブロック層711にかけて p -電極パッド710を形成する。

【0106】

この構成により、 p -電極パッド710から注入された電流が p 型透明電極709で拡げられ、活性層703に注入されて発光した光がフォトニクス結晶705で反射され、 p 型透明電極709を通して光が取り出される。

【0107】

フォトニクス結晶709では90%以上の光が反射される。これにより、電流値が20mAのときに光出力として8mW、発光波長として630nmが得られる。この値は、図17に示された従来の素子の約2倍の値であり、光取り出し効率が大幅に向上している。

【0108】

(8) 第8の実施の形態

本発明の第8の実施の形態による素子の構成を、図8を用いて説明する。

【0109】

本実施の形態は、貫通転位を有するフォトニクス結晶を、光取り出し面に形成したGa_xN_{1-x}系化合物半導体発光素子に相当する。

【0110】

サファイア基板801上に、Ga_xN_{1-x}バッファ層(図示せず)、 n 型Ga_xN_{1-x}層802、 n 型AlGa_xN_{1-x}クラッド層803、 $lnGa_xN_{1-x}$ 活性層804、 p -AlGa_xN_{1-x}クラッド層805、 p -Ga_xN_{1-x}コンタクト層809を順次結晶成長させている。

【0111】

さらに、 p -AlGa_xN_{1-x}クラッド層805、 $lnGa_xN_{1-x}$ 活性層804及び n 型AlGa_xN_{1-x}層803の一部をエッチングにより除去し、 n 型Ga_xN_{1-x}層802の表面を露出させる。 p -Ga_xN_{1-x}コンタクト層809上には p 側電極及びボンディング電極(透明である必要はない)806を形成し、さらに n 型Ga_xN_{1-x}層802上

にn側電極807を形成する。

【0112】

これとは別に、サファイア基板上に、例えばGaN等からなるフォトニクス結晶を作製しておく。ここで、サファイア基板上的GaNには、多くの貫通転位が存在する。このようなフォトニクス結晶808とサファイア基板801とを融着させる。この場合、サファイア基板801が透明であるので発光した光は基板801に吸収されない。

【0113】

このような構造によれば、p側電極806から流された電流は、p型GaNコンタクト層809からInGaN発光層804に電流が注入されて発光し、その光はフォトニクス結晶808を通して素子の外部に取り出される。

【0114】

フォトニクス結晶808は、上述したように多くの貫通転位を有する。このため、上記第7の実施の形態におけるフォトニクス結晶706のように光を反射するのではなく、貫通転位に沿って光が進み、チップ外に光が効率良く取り出される。このフォトニクス結晶808はフィルタとしても機能し、より波長半値幅の狭い単色性の高い発光が得られる。

【0115】

(9) 第9の実施の形態

第9の実施の形態について、図9を用いて説明する。これはフォトニクス結晶を導入しない場合の一例に相当する。

【0116】

本実施の形態は、GaN系化合物半導体発光素子であって、n-GaN基板901上にGaNバッファ層（図示せず）、n型GaNコンタクト層902、n型AlGaNクラッド層903、InGaN活性層904、p-AlGaNクラッド層905、p-GaNコンタクト層911を順次結晶成長し、p-GaNコンタクト層911、p-AlGaNクラッド層905、InGaN活性層904及びn型AlGaNクラッド層903、n型GaNコンタクト層902の一部をエッチング除去してn型GaN層902の表面を露出している。

【0117】

p型AlGa_N層905上に、p側透明電極906を形成し、このp側透明電極906に隣接して電流阻止用の絶縁膜から成る電流ブロック層907を形成し、電流ブロック層907上に、p側透明電極906と接続されたp側ボンディング電極908を形成する。さらに、n型Ga_Nコンタクト層902上にN側電極910を形成する。

【0118】

ここで、n-Ga_N層902の界面に凹凸を形成した後、n-AlGa_Nクラッド層903を成長させて、屈折率に分布を持たせている。n-Ga_N層14の界面に凹凸を形成する方法として、例えば図10(a)～図10(d)、あるいは図11(a)～図11(c)に示された方法等を用いてもよい。

【0119】

図10に示された方法は、先ず図10(a)に示されたように、サファイア基板2000上に、Ga_Nバッファ層2001、n型Ga_Nコンタクト層2002を順次形成する。

【0120】

図10(b)のように、レジストを塗布して写真蝕刻法を用いてパターニングを行い、レジスト膜2003を形成する。

【0121】

図10(c)のように、レジスト膜2003をマスクとしてn型Ga_Nコンタクト層2002の表面に凹凸を形成する。

【0122】

この後、図10(d)のように、p-AlGa_Nクラッド層2003を形成して表面を平坦化する。

【0123】

あるいは、図11に示された方法は、先ず図11(a)に示されたように、サファイア基板2100上に、Ga_Nバッファ層2101、n型Ga_Nコンタクト層2102を順次形成する。

【0124】

図11 (b) のように、例えば反応性イオンエッチングの際のエッチングガスの流量比を $\text{BCl}_3 : \text{Cl}_2 = 1 : 1$ にすることにより、 Cl_2 ガスの比を高くすると、 n 型 GaN コンタクト層 2102 の表面に荒れが発生する。

【0125】

この後、図11 (c) のように、 p - AlGaIn クラッド層 2103 を形成して表面を平坦化する。

【0126】

本実施の形態によれば、 n - GaIn 層 902 の界面の凹凸が形成され、 n - AlGaIn クラッド層 903 との屈折率に分布が存在することにより、その界面において光が反射、散乱されるので、素子外部へ取り出される光が増加する。

【0127】

(10) 第10の実施の形態

第10の実施の形態に係わる素子を、図12を用いて説明する。図12 (a) に示されるように、基板 2200 上に図示されていないバッファ層、クラッド層 2201、活性層 2202、クラッド層 2203 を順次形成し、基板 2200 の素子形成面と反対側の面上にレジスト膜 2204 を形成する。

【0128】

図12 (b) に示されるように、レジスト膜 2204 を加熱すると、エッジ部分にだれが生じる。

【0129】

図12 (c) に示されるように、レジスト膜 2204 をマスクとしてイオンミリング法によりエッチングすると、レジスト膜 2204 のだれに応じた形状に半導体基板 2200 のエッジ部分が加工される。

【0130】

図12 (d) のように、基板 2200 に反射率の高いフォトリソ結晶層 2204 を溶着する。

【0131】

本実施の形態によれば、図12 (d) において矢印により図示されたように、活性層 2202 から発光した光が、基板 2200 のエッチングされた部分におい

て様々な角度に反射されるので、光の取り出し効率が向上し、発光強度が高くなる。

【0132】

(11) 第11の実施の形態

フォトニクス結晶上に、サファイア基板上に形成した発光素子と同様であって発光波長の異なる発光素子を3つ形成することで、3波長で発光する発光素子が実現される。

【0133】

図13に示されたように、フォトニクス結晶層2300の一方の面上に青色発光素子2302、緑色発光素子2303を形成し、他方の面上に赤色発光素子2301を形成する。

【0134】

青色発光素子2302及び緑色発光素子2303からの短波長の光が、フォトニクス結晶層2300を通過して赤色発光素子2301の活性層を光励起して発光させてしまわないように、短波長領域の光に対して反射率の高いフォトニクス結晶層2300を設け、その裏面側に長波長の光を発光する赤色発光素子2301を融着させている。これにより、青色、緑色及び赤色の光が混色し、白色が得られる。

【0135】

ここで、複数の発光素子の色の組合せは必要に応じて様々に変えることが可能であり、これに応じて混色された色も変化する。

【0136】

(12) 第12の実施の形態

本発明の第12の実施の形態について、図14を用いて説明する。本実施の形態は、Ga₂N系のRC-LED (Resonance Cavity LED) である。Ga₂N系の透明な半導体基板2400上に、n-Ga₂Nバッファ層2401、AlGa₂N/Ga₂Nから成る中程度の反射率を有するDBR (Distributed Bragg Reflector) 層2402を形成し、さらにInGa₂N-多重量子井戸構造 (MQW) 活性層2403、p-AlGa₂Nクラッド層2404、p-InGa₂N接着層2405を

形成する。

【0137】

さらに、別途準備した、高い反射率を有するフォトニクス結晶層2406を接着層2405を介してクラッド層2404に接着する。そして、フォトニクス結晶層2406の上面にp電極2407、半導体基板2400の上面にn電極2408を形成する。

【0138】

GaN系半導体材料を用いたのでは、高反射率を有するDBR層を得ることが困難である。そこで、フォトニクス結晶層2406を導入することで、高い光取り出し効率を実現することができる。

【0139】

ここで、各層の材料は上記材料に限定されず、GaN系の他の半導体材料であってもよく、あるいはGaAs系の半導体材料等を用いてもよい。但し、GaAs系材料を用いた場合は、GaAsが発光した光を吸収してしまうため、基板を除去して発光層をGaP基板等に融着させる必要がある。

【0140】

本実施の形態による素子は、VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) に適用することもできる。

【0141】

次に、GaN系フォトニクス結晶の形成方法を図15を用いて説明する。

【0142】

図15(a)に示されたように、GaN基板2500上に、バッファ層2501、 $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}_{(1-x-y)}\text{N}$ ($0 \leq x, y \leq 1$) 層2502を形成する。

【0143】

図15(b)に示されたように、 $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}_{(1-x-y)}\text{N}$ 層2502をパターニングし、格子状に加工する。

【0144】

このような加工を施した基板と、同じ構成を有するGaN基板2600、バッ

ファ層2601、 $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}(1-x-y)\text{N}$ 層2602から成る基板とを用意し、図15(c)に示されたように格子状の層2502と層2602とが直交するように位置あわせしながら融着する。

【0145】

そして、図15(d)に示されたように、一方の基板2600をレーザ光照射によって剥離する。

【0146】

さらに、図15(e)のように、反応性イオンエッチングによりバッファ層2601を除去する。

【0147】

以上の図15(a)～図15(e)の工程をさらに繰り返すことで、回折格子を有するフォトニクス結晶を作製する。ここで、互いに平行する一つおきの回折格子は、発光する光の半周期分位相がずれている必要がある。

【0148】

上述した第7～第12の実施の形態によれば、化合物半導体発光素子の発光層の少なくとも一方の面に、フォトニクス結晶領域、あるいは所定の屈折率分布を有する領域を備えている。

【0149】

特に、フォトニクス結晶は、バンドギャップに対応した光が存在できないため、高反射膜として作用する。また垂直入射以外の成分に対しても、大きい反射率を有するため、反射層として導入することで光取り出し効率を向上させることができる。

【0150】

あるいは、 GaN 系化合物半導体発光素子では、 GaN 層に多くの貫通転位が存在する。このような結晶を用いてフォトニクス結晶を作製すると、基板に融着したフォトニクス結晶には多くの貫通転位が存在する。このため、この転位に沿って光が進み、素子外部に光が効率良く取り出される。この場合のフォトニクス結晶は、フィルタとしても作用するので、波長半値幅の狭い単色性の高い発光が得られる。

【0151】

また、フォトリソ法結晶上にサファイア基板上に形成した発光素子と発光波長の異なる発光素子を形成しておくことにより、2波長で発光する発光素子を得ることができる。

【0152】

あるいは、半導体層の界面に凹凸を形成しておくことで、半導体層内部に屈折率分布が存在し、この界面において光が反射し散乱することにより、より効果的に素子外部に光を取り出すことができる。

【0153】

このような半導体層内部において屈折率に分布を持たせるには、屈折率の異なる半導体層を組み合わせることで実現してもよい。

【0154】

このように、屈折率分布を持たせた領域において、活性層から発光した光をチップ内でより多く反射させて光取り出し面側で光を取り出すことにより、光取り出し効率を大幅に向上させることが可能となり、高輝度化が実現される。

【0155】

また、高輝度化により、注入電流をより小さくすることができるため、素子の信頼性の向上にも寄与する。

【0156】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、透光性を有する基板から光を取り出すことにより、光取り出し効率の向上及び高輝度化が実現され、また基板に格子整合したバッファ層を有するため、結晶性が良く長寿命を達成することができる。

【0157】

さらに、第1、第2電極が同一面側に形成されることから、このうちの一つの電極を放熱板上に直接形成することで、大電流まで光出力が飽和することなく高輝度化が実現される。

【0158】

透光性を有する基板上に形成されたコンタクト層に凹状の領域を設けることで

、発光層からの光を側面等に反射して素子外部へ有効に取り出せることができるので、光取り出し効率が向上する。

【0159】

素子形状が多角柱、あるいは円柱であることから、四角柱である場合と比較して端面での全反射が減少し、素子内部の光を端面から外部へ有効に取り出すことが可能であり、光取り出し効率が向上する。

【0160】

あるいはまた、発光層の一方の面にフォトリソ結晶層、あるいは半導体層内部において屈折率分布を有する領域が設けられていることにより、発光層において発光した光が効率よく素子の外部へ取り出されるので、取り出し効率が向上し高輝度化が実現される。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図2】

本発明の第2の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図3】

本発明の第3の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図4】

本発明の第4の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図5】

本発明の第5の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図6】

本発明の第6の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図 7】

本発明の第 7 の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図 8】

本発明の第 8 の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図 9】

本発明の第 9 の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図

【図 1 0】

同第 9 の実施の形態による半導体発光素子における G a N 層の表面に凹凸を形成する方法を示した縦断面図。

【図 1 1】

同第 9 の実施の形態による半導体発光素子における G a N 層の表面に凹凸を形成する他の方法を示した縦断面図。

【図 1 2】

本発明の第 1 0 の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図。

【図 1 3】

本発明の第 1 1 の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図。

【図 1 4】

本発明の第 1 2 の実施の形態による半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図。

【図 1 5】

G a N を用いたフォトリソグラフィ結晶の作製方法の手順を示す縦断面図。

【図 1 6】

従来の半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図。

【図 1 7】

従来の他の半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図。

【図 1 8】

GaNを用いたフォトリソ結晶の作製方法の手順を示す縦断面図。

【図 1 9】

従来のさらに他の半導体発光素子の断面構造を示した縦断面図。

【符号の説明】

1 0 0 ZnSe 基板

1 0 1 $\text{In}(x_1)\text{Ga}(y_1)\text{Al}(1-x_1-y_1)$ Pからなるバッファ層

1 0 2 $\text{In}(x_2)\text{Ga}(y_2)\text{Al}(1-x_2-y_2)$ Pからなるn型コンタクト層

1 0 3 $\text{In}(x_3)\text{Ga}(y_3)\text{Al}(1-x_3-y_3)$ Pからなるn型クラッド層

1 0 4 $\text{In}(x_4)\text{Ga}(y_4)\text{Al}(1-x_4-y_4)$ Pからなる活性層

1 0 5 $\text{In}(x_5)\text{Ga}(y_5)\text{Al}(1-x_5-y_5)$ PからなるP型クラッド層

1 0 6 $\text{In}(x_6)\text{Ga}(y_6)\text{Al}(1-x_6-y_6)$ PからなるP型コンタクト層

1 0 7 n型電極

1 0 8 p型電極

2 0 0 GaAs 半導体基板

2 0 1 $\text{In}(x_1)\text{Ga}(y_1)\text{Al}(1-x_1-y_1)$ Pからなるバッファ層

2 0 2 $\text{In}(x_2)\text{Ga}(y_2)\text{Al}(1-x_2-y_2)$ Pからなるn型コンタクト層

2 0 3 $\text{In}(x_3)\text{Ga}(y_3)\text{Al}(1-x_3-y_3)$ Pからなるn型クラッド層

2 0 4 $\text{In}(x_4)\text{Ga}(y_4)\text{Al}(1-x_4-y_4)$ Pからなる活性層

205 In (x5) Ga (y5) Al (1-x5-y5) Pからなるp型クラッド層

206 In (x6) Ga (y6) Al (1-x6-y6) Pからなるp型コンタクト層

207 n型電極

208 p型電極

300 n型GaP基板

301 In (x1) Ga (y1) Al (1-x1-y1) Pからなるバッファ層

302 In (x3) Ga (y3) Al (1-x2-y2) Pからなるn型クラッド層

303 In (x4) Ga (y4) Al (1-x3-y3) Pからなる活性層

304 In (x5) Ga (y5) Al (1-x5-y5) Pからなるp型クラッド層

305 In (x6) Ga (y6) Al (1-x6-y6) Pからなるp型コンタクト層

306 n型電極

307 p型電極

308 光取り出し窓

400 ZnSe基板

401 n-InGaAlPバッファ層

402 n-InGaAlPクラッド層

403 InGaAlP活性層

404 p-InGaAlPクラッド層

405 P-InGaAlPコンタクト層

406 n型電極

407 p型電極

500 n型GaPからなる基板

501 In (x1) Ga (y1) Al (1-x1-y1) Pからなるn型バッ

ファ層

502 In (x2) Ga (y2) Al (1-x2-y2) Pからなるn型クラッド層

503 In (x3) Ga (y3) Al (1-x3-y3) Pからなる活性層

504 In (x4) Ga (y4) Al (1-x4-y4) Pからなるp型クラッド層

505 In (x5) Ga (y5) Al (1-x5-y5) Pからなるp型コンタクト層

506 AuGeNiからなるn型電極

507 AuZnからなるp型電極

600 n型GaNからなる基板

601 In (x1) Ga (y1) Al (1-x1-y1) Nからなるn型バッファ層

602 In (x2) Ga (y2) Al (1-x2-y2) Nからなるn型クラッド層

603 In (x3) Ga (y3) Al (1-x3-y3) Nからなる活性層

604 In (x4) Ga (y4) Al (1-x4-y4) Nからなるp型クラッド層

605 In (x5) Ga (y5) Al (1-x5-y5) Nからなるp型コンタクト層

606 TiAuからなるn型電極

607 NiAuからなるp型電極

700 p-GaAs基板

701 p-GaNバッファ層

702 p-InGaAlPクラッド層

703 InAlGaP活性層

704 n-InGaAlPクラッド層

705 フォトニクス結晶層

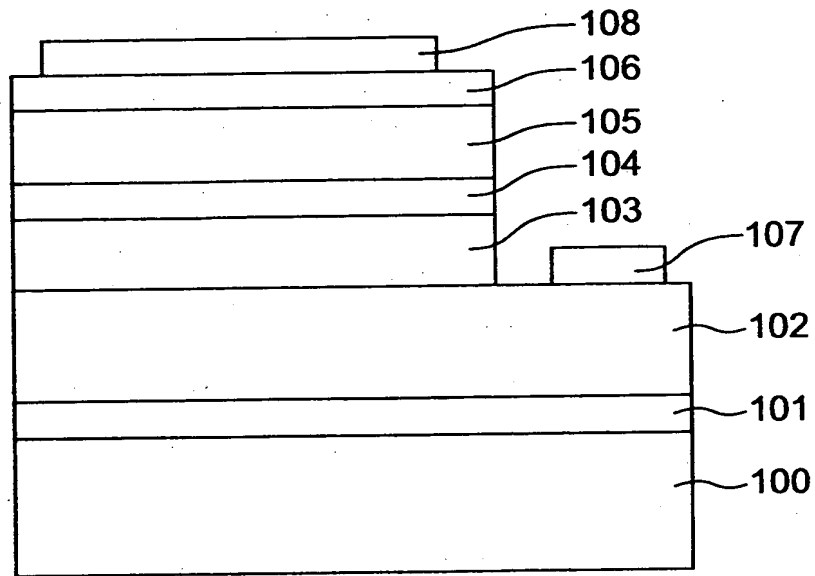
706 n-GaAs層

708 N電極
 709 p透明電極
 710 p電極パッド
 711 ブロック層
 712 p-GaNコンタクト層
 801 サファイア基板
 802 n-GaNコンタクト層
 803 n-AlGaN層
 804 InGaN活性層
 805 p-AlGaNクラッド層
 806 p電極パッド
 807 N電極
 808 フォトニクス結晶層
 809 p-GaNコンタクト層
 901 n-GaN基板
 902 n-GaNコンタクト層
 903 n-AlGaNクラッド層
 904 InGaN活性層
 905 p-AlGaNクラッド層
 906 p透明電極
 908 pボンディング電極パッド
 909 凹凸が形成された屈折率分布層
 910 n電極
 911 p-GaNコンタクト層
 2000 サファイア基板
 2001 GaNバッファ層2001
 2002 n型GaNコンタクト層
 2003 レジスト膜
 2100 サファイア基板

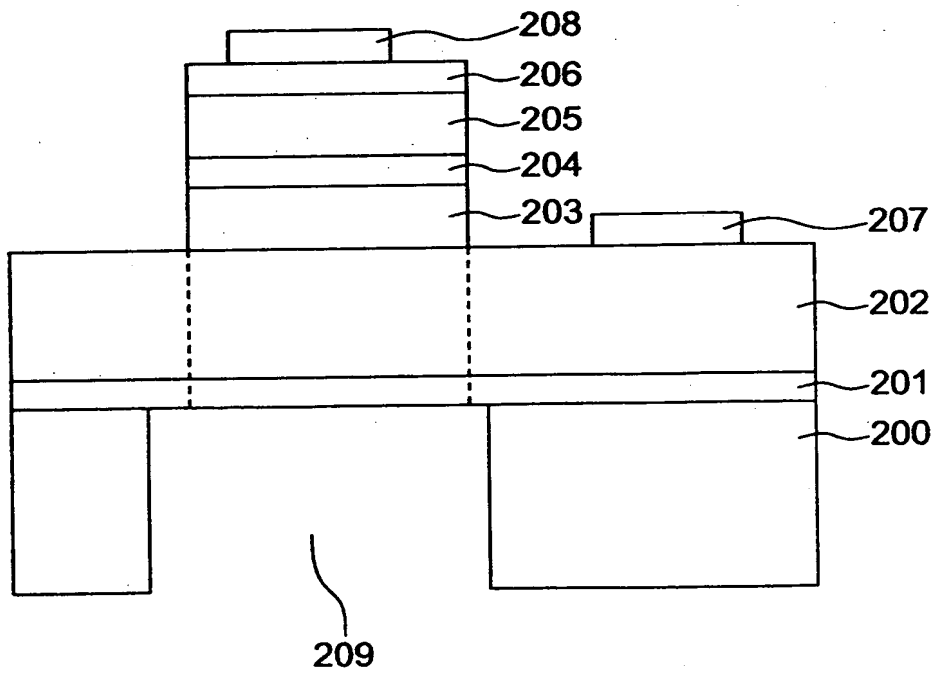
- 2101 GaNバッファ層
- 2102 n型GaNコンタクト層
- 2103 p-AlGa_Nクラッド層
- 2200 基板
- 2201 クラッド層
- 2202 活性層
- 2203 クラッド層
- 2204 レジスト膜
- 2300 フォトニクス結晶層
- 2301 赤色発光素子
- 2302 青色発光素子
- 2303 緑色発光素子
- 2400 半導体基板
- 2401 n-GaNバッファ層
- 2402 DBR層
- 2403 InGa_N-多重量子井戸構造 (MQW) 活性層
- 2404 p-AlGa_Nクラッド層2404
- 2405 p-InGa_N接着層
- 2406 フォトニクス結晶層
- 2407 p電極
- 2408 n電極
- 2500 Ga_N基板
- 2501 バッファ層
- 2502 $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}_{(1-x-y)}\text{N}$ ($0 \leq x, y, z \leq 1$) 層
- 2600 Ga_N基板
- 2601 バッファ層
- 2602 $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}_{(1-x-y)}\text{N}$ 層

【書類名】 図面

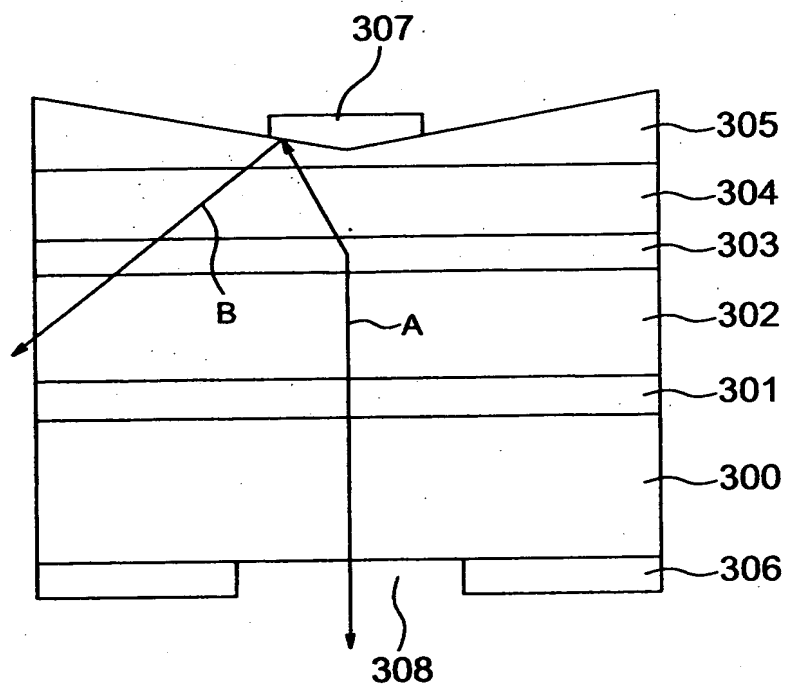
【図 1】



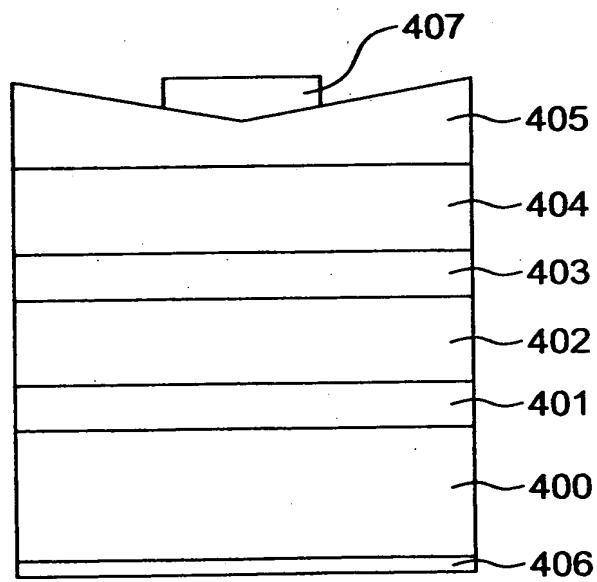
【図 2】



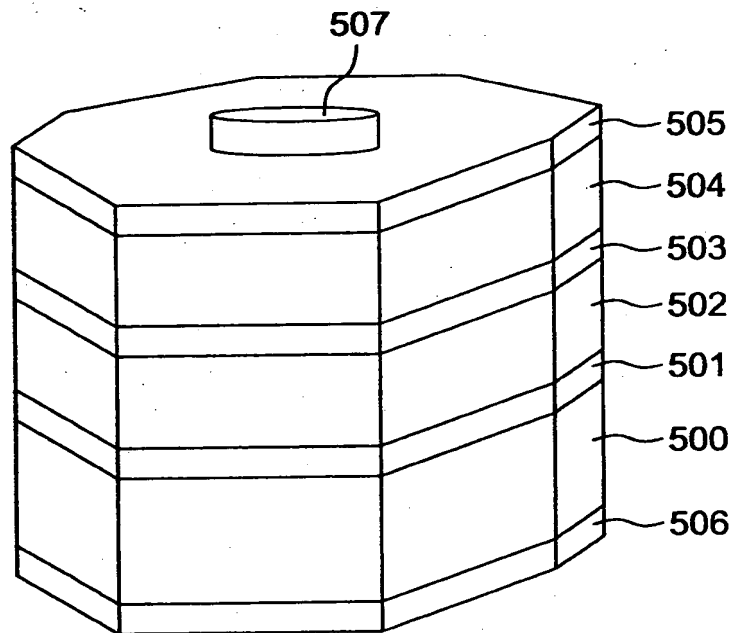
【図3】



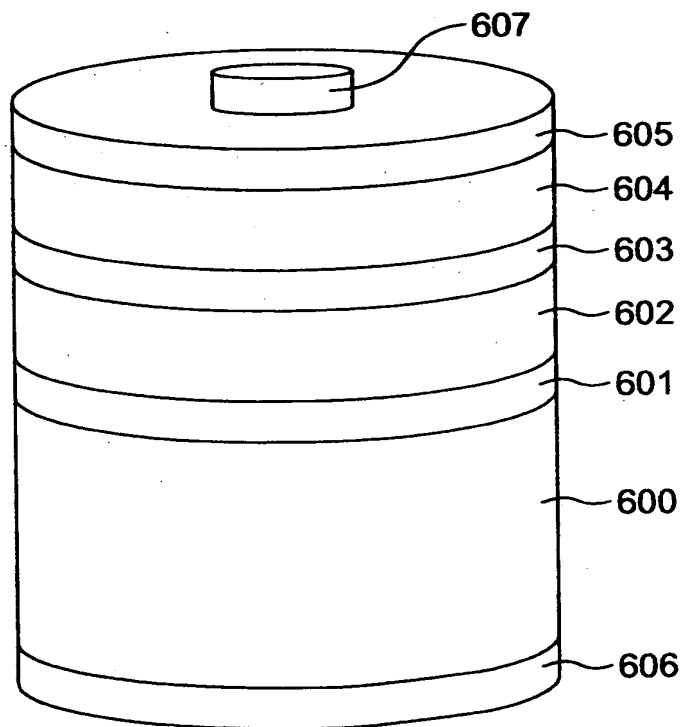
【図4】



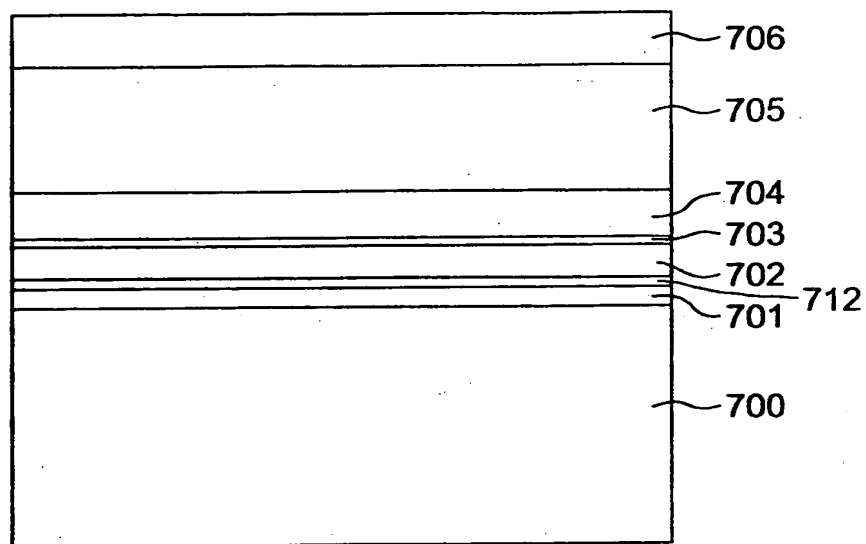
【図 5】



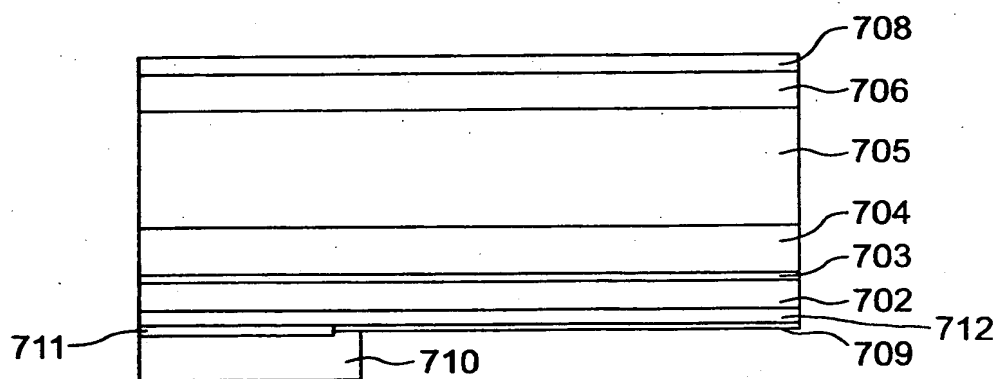
【図 6】



【図 7】

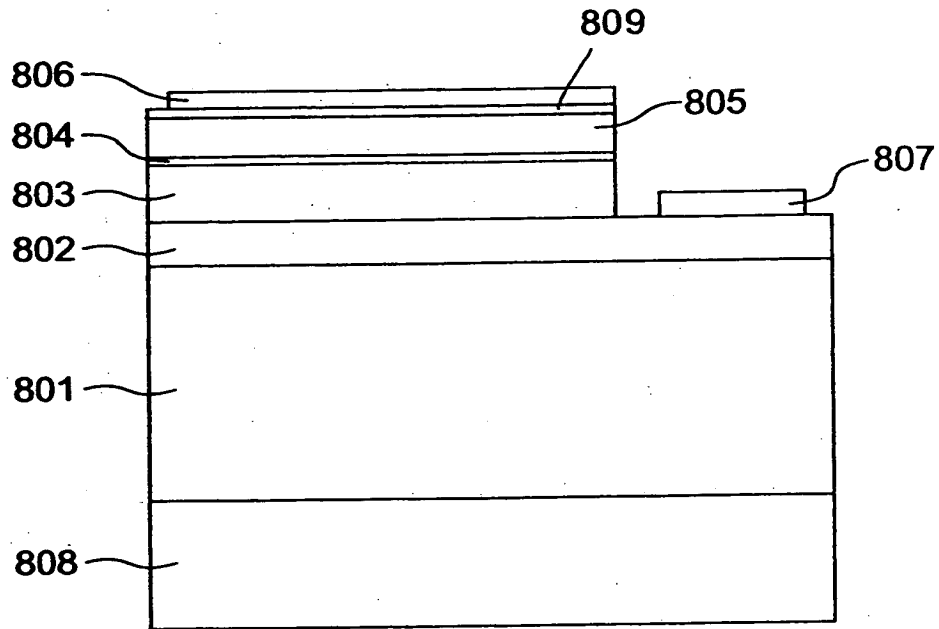


(a)

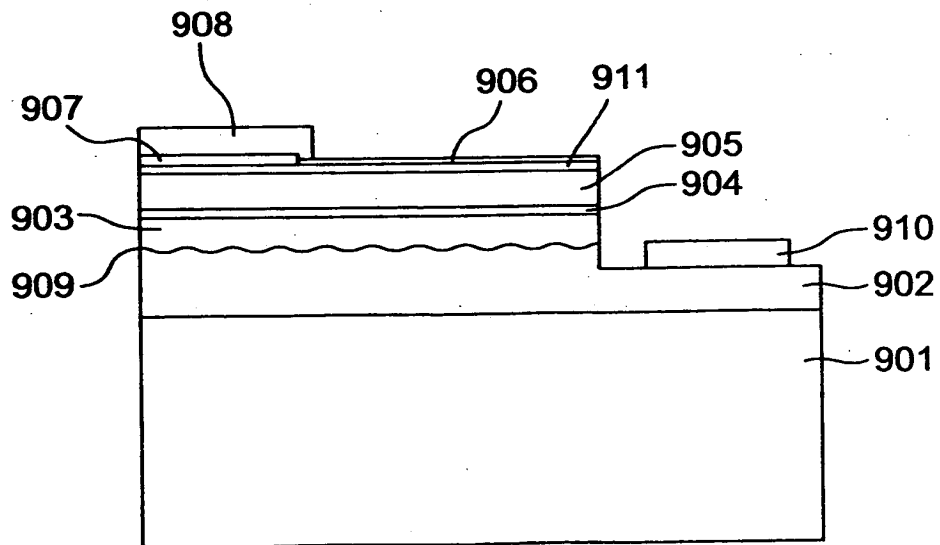


(b)

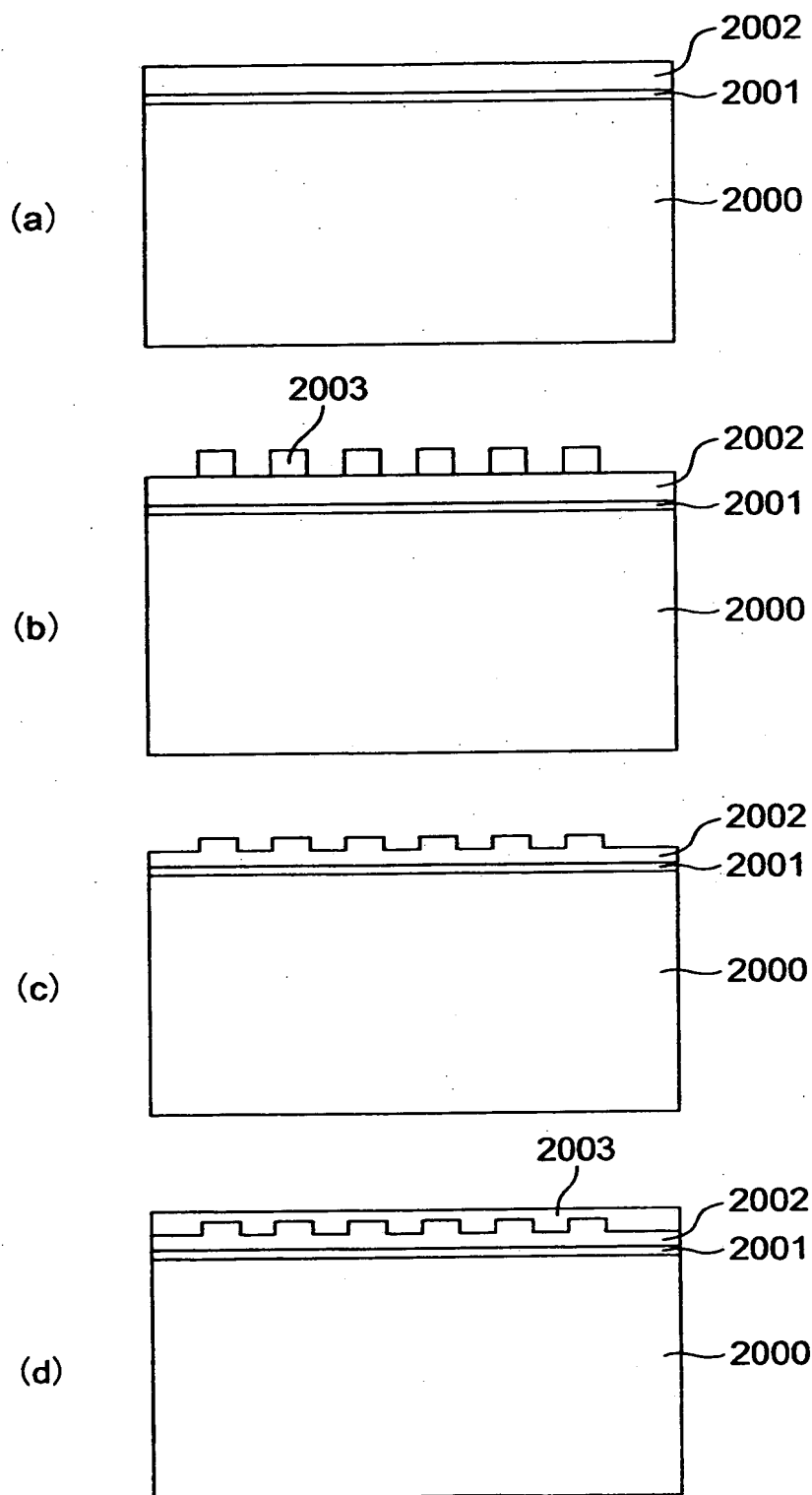
【図8】



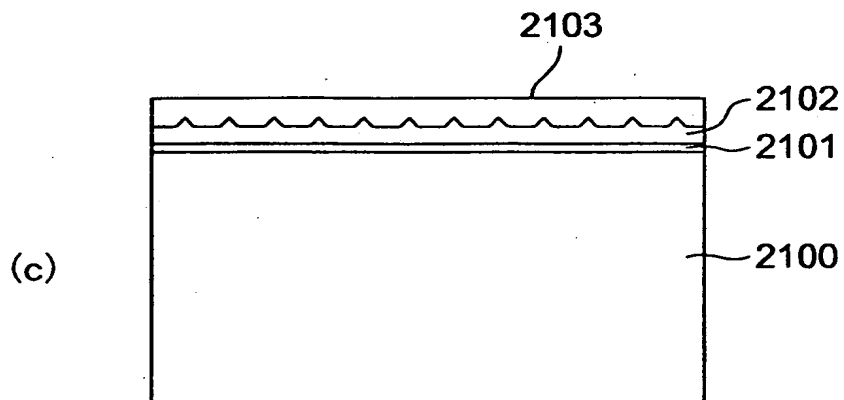
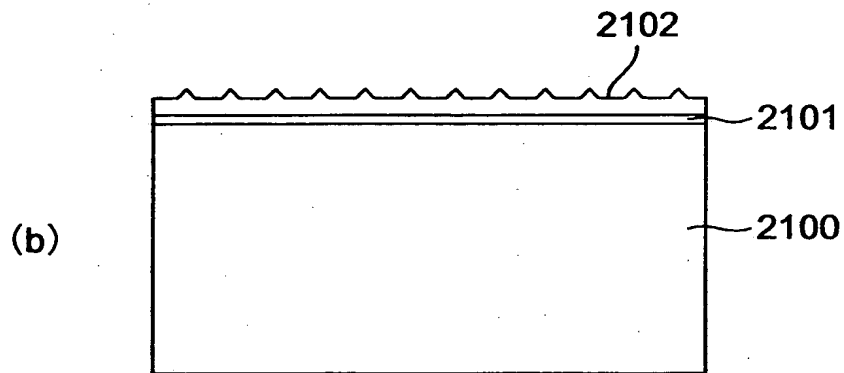
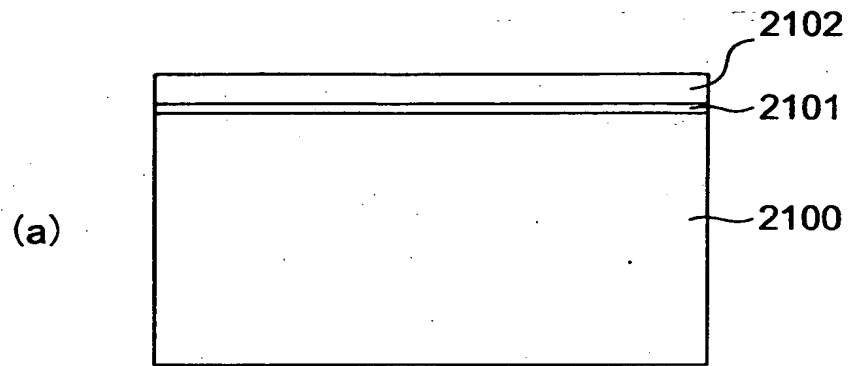
【図9】



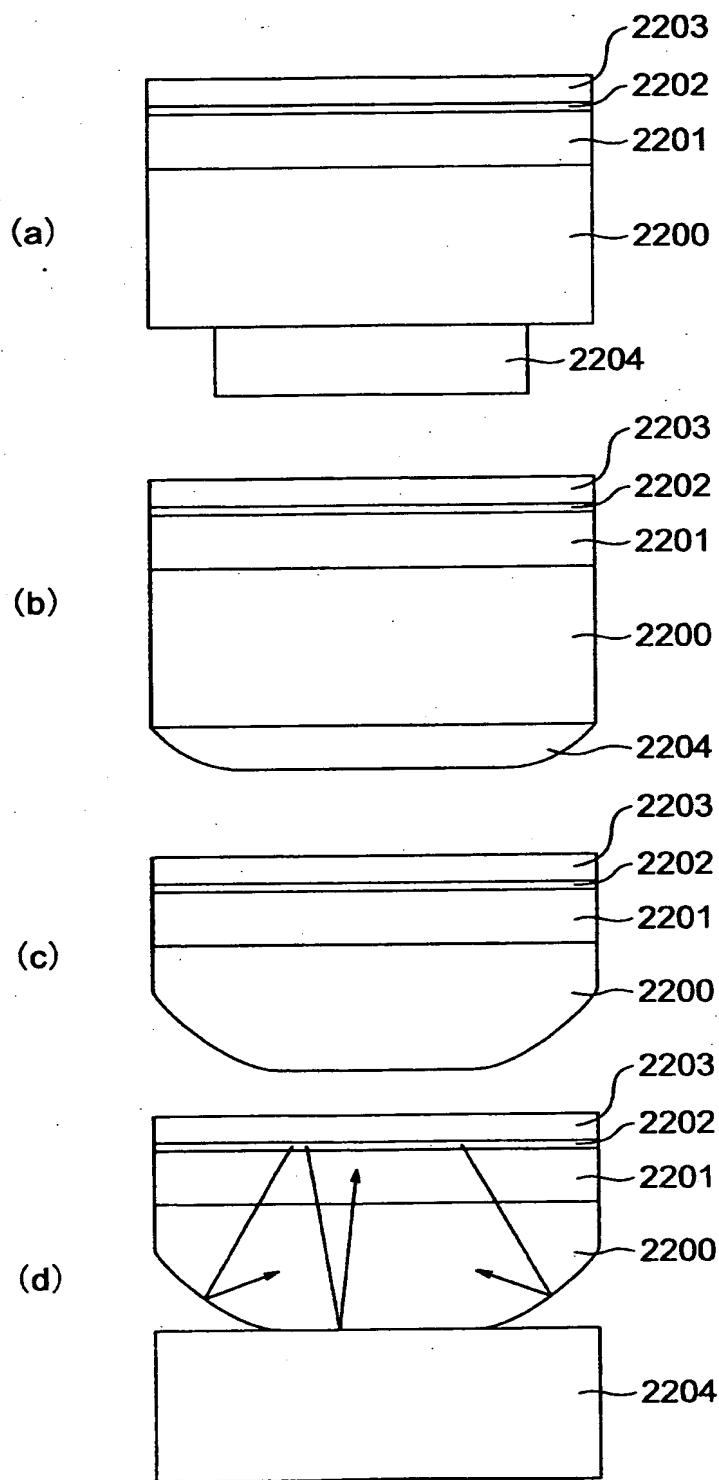
【図 1 0】



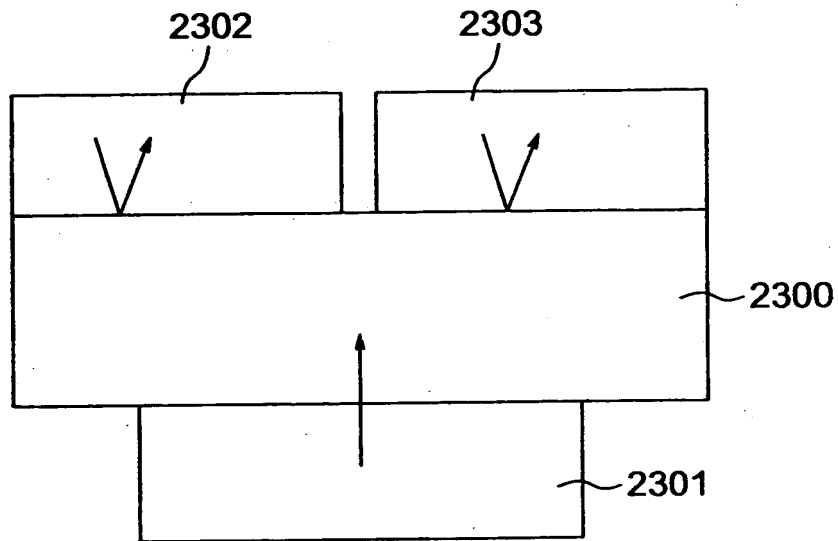
【図 1 1】



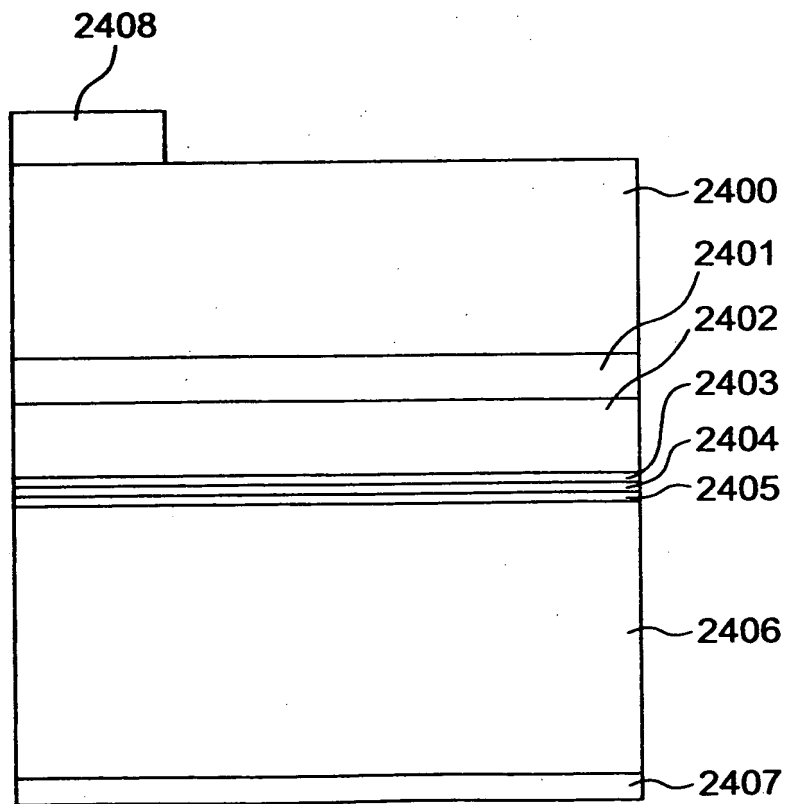
【図 1 2】



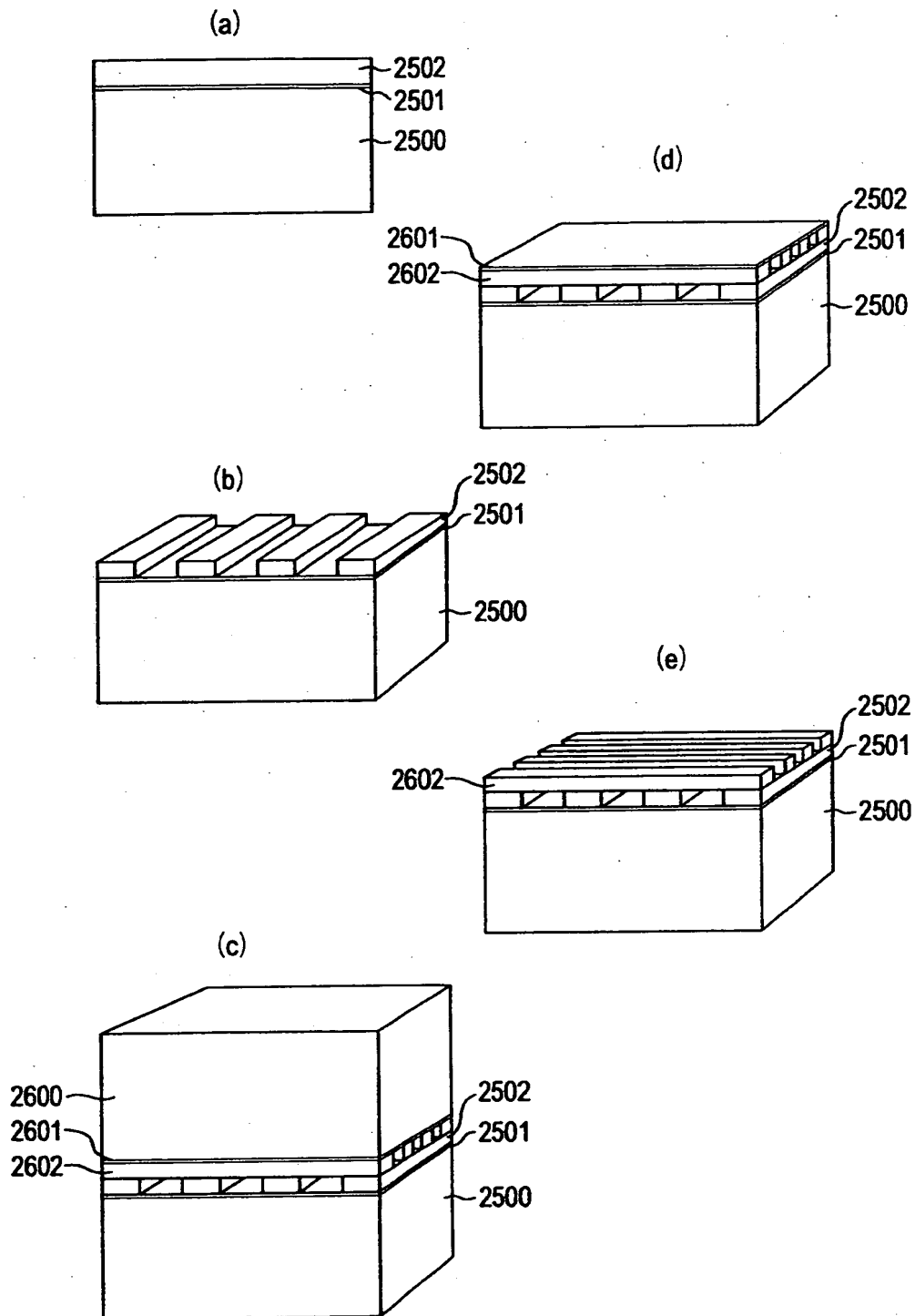
【図 1 3】



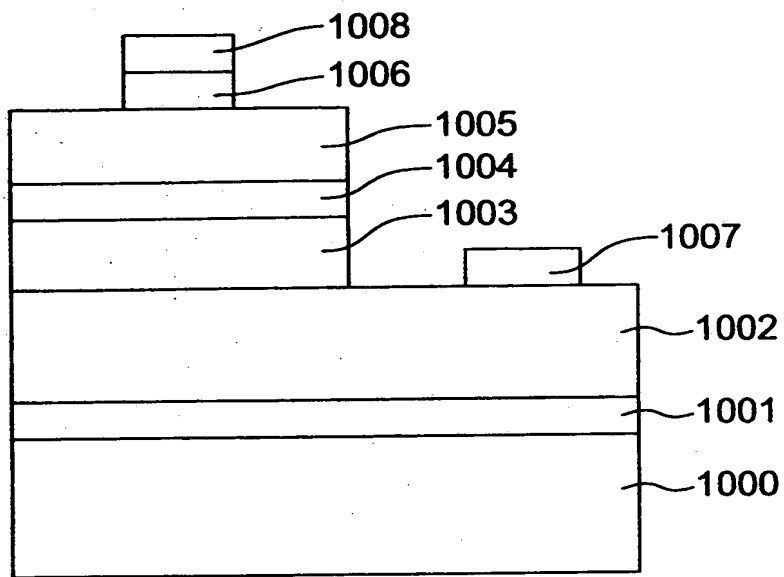
【図 1 4】



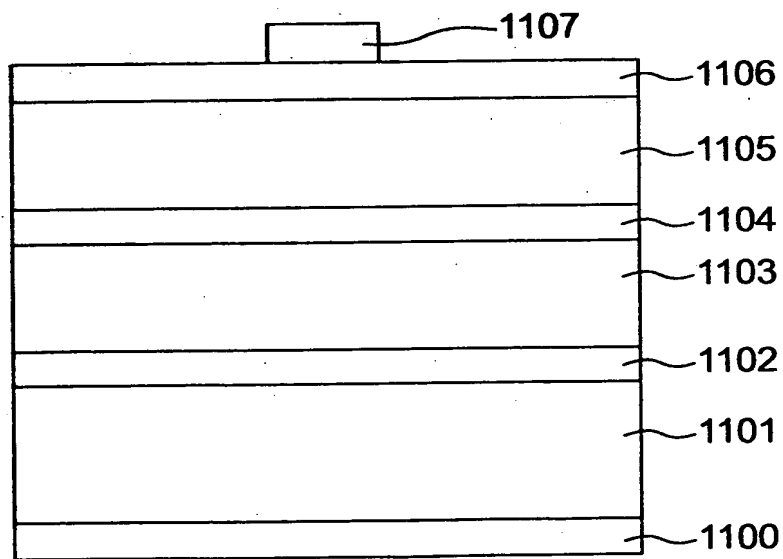
【図 1 5】



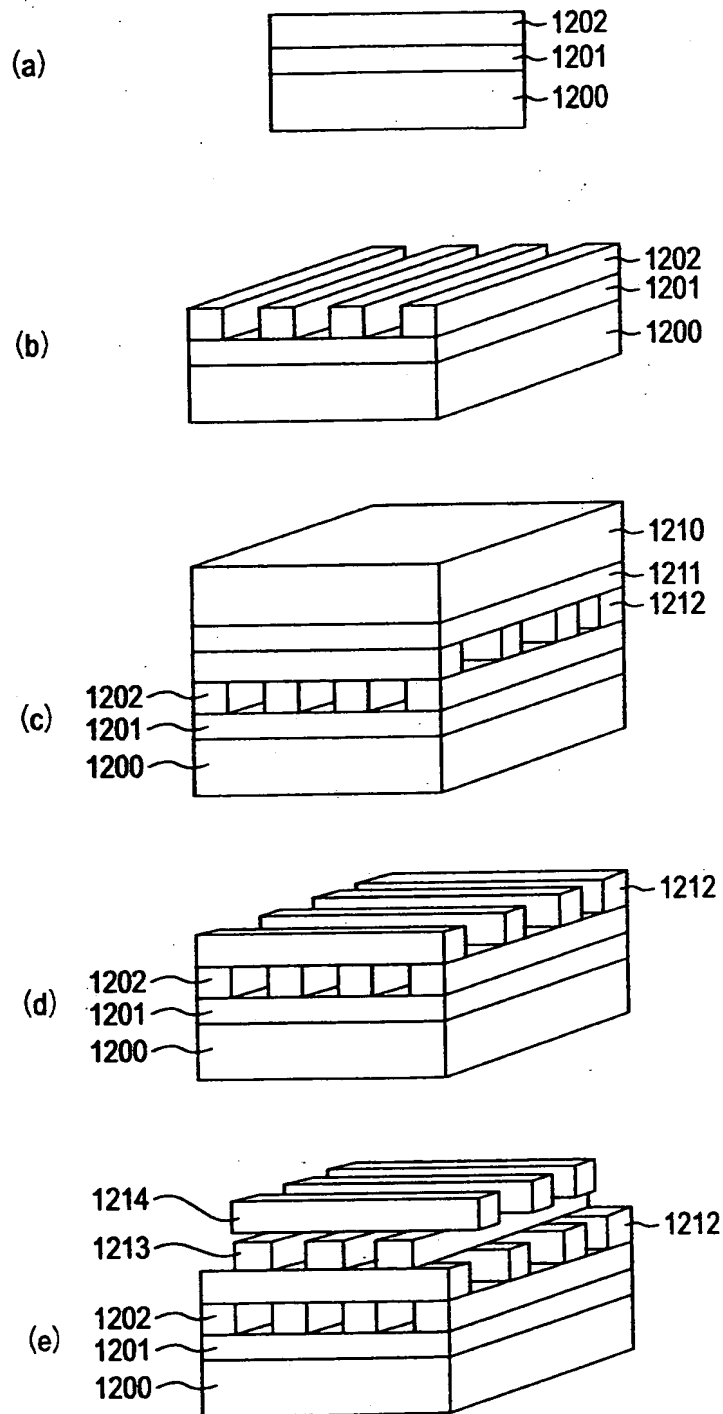
【図 16】



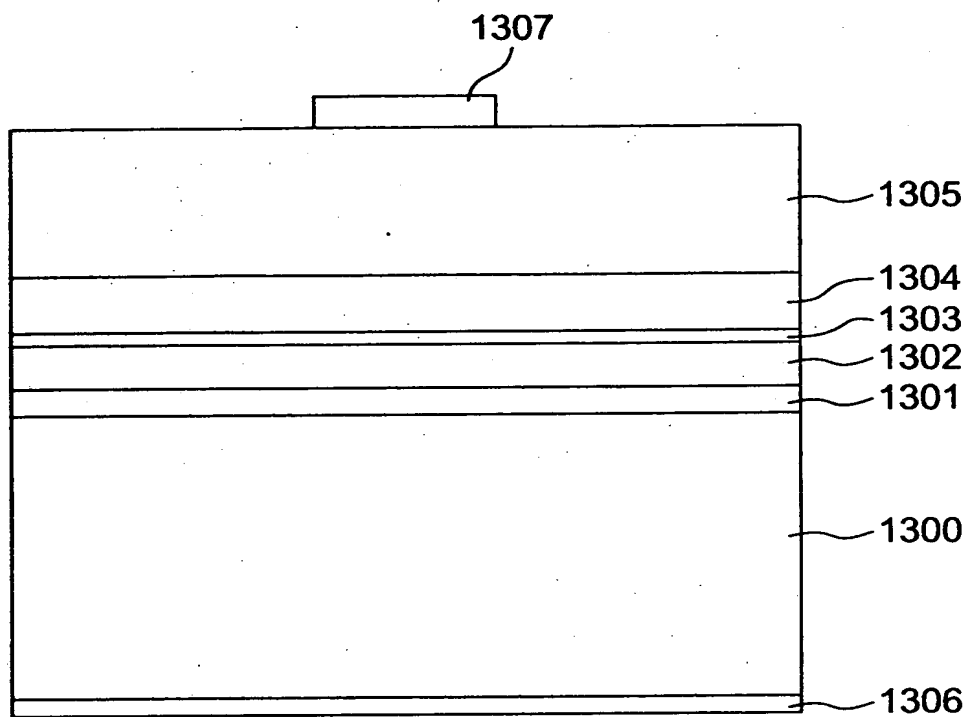
【図 17】



【図 1 8】



【図 1 9】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光取り出し効率を向上させる。

【解決手段】 透光性を有する半導体基板100、この半導体基板100上に、半導体基板100に対して格子整合したバッファ層101、バッファ層101上に形成された発光層104、バッファ層101上に配置された第1電極107、発光層104上に配置された第2電極108を備え、発光層104から出射された光を透光性を有する基板100側から取り出すことで、光取り出し効率が向上する。

【選択図】 図1



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000221339]

1. 変更年月日	1992年 5月22日
[変更理由]	住所変更
住 所	神奈川県川崎市川崎区日進町7番地1
氏 名	東芝電子エンジニアリング株式会社



出願人履歴情報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日

1990年 8月22日

[変更理由]

新規登録

住所

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

氏名

株式会社東芝